

Кремниевый фотодетекторный чип 410×410 мкм — техническое описание

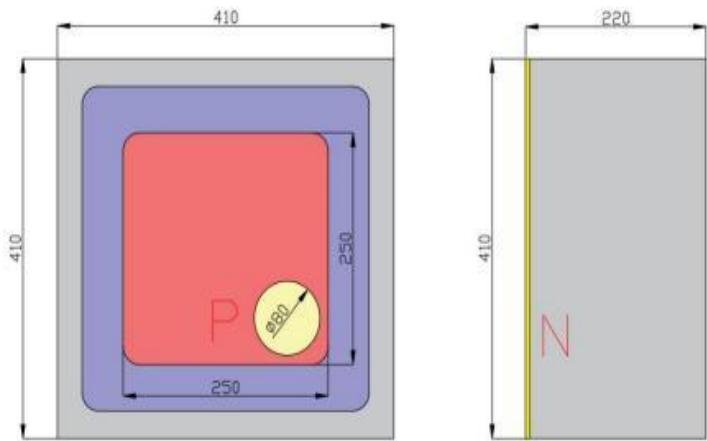
P/N : WS99-01A

Особенности

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) — Au,
верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	250± 10 x 250± 10			мкм
Ширина чипа	410			мкм
Длина чипа	410			мкм
Высота чипа	200	220	245	мкм
Размер контактной площадки		80		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	30			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ		400	940	1100	нм
Емкость	Cj	VR=3V, f=1MHz		2		пФ